	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 <b>W2XP030M</b>	文件编号	临时
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页码	1/2

## 1 主要用途及主要特点

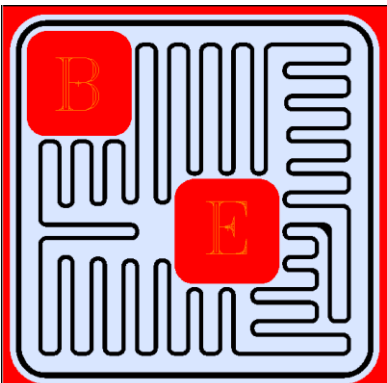
### 1.1 主要用途

用W2XP030M 芯片封装的成品管主要用于低压电源调整电路及一般高频放大电路。

### 1.2 主要特点

- 电流特性好
- 饱和电压低

## 2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	1.1×1.1	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20	
	划片道尺寸 (μm)	50	
	键合区面积 (μm <sup>2</sup> )	基区	300×300
		发射区	300×300
	钝化层		Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	4.0±0.6
	背面电极	金属	银
	硅片直径 (mm)		φ125
	装片要求(推荐)		铅锡烧结

## 3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

### 3.1 极限值

除非另有规定, T<sub>amb</sub> = 25℃

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V <sub>CB0</sub>	100	V	推荐封装形式: T0-126 推荐成品型号: SSTIP32C
集电极-发射极电压	V <sub>CE0</sub>	100	V	
发射极-基极电压	V <sub>EB0</sub>	5	V	
集电极电流	I <sub>C</sub>	1.5	A	
耗散功率(Ta=25℃)	P <sub>tot</sub>	1.25	W	
结温	T <sub>j</sub>	150	℃	
贮存温度	T <sub>stg</sub>	-55~150	℃	

### 3.2 电参数


除非另有规定, T<sub>amb</sub> = 25℃

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =-80V, I <sub>E</sub> =0			1	μA
发射极-基极截止电流	I <sub>EB0</sub>	V <sub>EB</sub> = -5V, I <sub>C</sub> =0			1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =-2V, I <sub>C</sub> =-500mA	100		200	
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CEsat</sub>	I <sub>C</sub> =-3A, I <sub>B</sub> =-300mA			1	V
特征频率	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> =-10V, I <sub>C</sub> =-100mA f=30MHZ	30			MHz

## 江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号  
电话: (0510) 86851182

网址: <http://www.xs-elec.com>  
传真: (0510) 86851532

	<b>江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片</b> <b>W2XP030M</b>	文件编号	临时
	<b>高频放大环境额定双极型晶体管</b>	版本号	18-B1-06
		页 码	2/2

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度  $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

---

**江阴新顺微电子有限公司**

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网 址：<http://www.xs-elec.com>

电 话：(0510) 86851182

传 真：(0510) 86851532

---